

# EUROPEAN PATENT OFFICE

K

## Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER : 56006492  
PUBLICATION DATE : 23-01-81

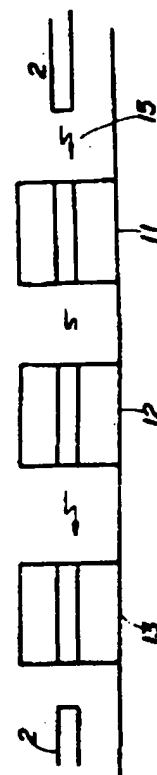
APPLICATION DATE : 26-06-79  
APPLICATION NUMBER : 54081204

APPLICANT : SHARP CORP;

INVENTOR : INOUE TADAAKI;

INT.CL. : H01S 3/18 H01L 31/00 H01L 33/00

TITLE : LIGHT AMPLIFIER



ABSTRACT : PURPOSE: To obtain an output signal having high S/N ratio from a light amplifier by coupling semiconductor lasers having different oscillation outputs on a light irradiating line and sequentially coupling between the respective semiconductor lasers to input signal.

CONSTITUTION: A semiconductor laser (LD) 11 of the first stage is in oscillated state, and is moved slightly in the oscillated state toward an increase in the output by the coupling effect of an input light signal inputted from a fiber 2. An LD 12 of the second stage is turned on due to the increase in the oscillation due to the coupling effect of the LD 11 of the first stage to start oscillation. Although an LD 13 of the third stage is set in oscillated state, when the LD 12 of the second stage starts oscillating, it transfers its oscillating state so as to transmit the light signal due to only the delay of the coupling time.

COPYRIGHT: (C)1981,JPO&Japio

⑨ 日本国特許庁 (JP)  
⑩ 公開特許公報 (A)

⑪ 特許出願公開  
昭56—6492

⑫ Int. Cl.<sup>3</sup>  
H 01 S 3/18  
H 01 L 31/00  
33/00

識別記号  
庁内整理番号  
7377—5F  
6824—5F  
7739—5F

⑬ 公開 昭和56年(1981)1月23日  
発明の数 1  
審査請求 未請求

(全 4 頁)

⑭ 光増幅器

大阪市阿倍野区長池町22番22号  
シャープ株式会社内

⑮ 特 願 昭54—81204  
⑯ 出 願 昭54(1979)6月26日  
⑰ 発 明 者 富田孝司  
大阪市阿倍野区長池町22番22号  
シャープ株式会社内  
⑱ 発 明 者 幸木俊公

⑲ 発 明 者 井上忠昭  
大阪市阿倍野区長池町22番22号  
シャープ株式会社内  
⑳ 出 願 人 シャープ株式会社  
大阪市阿倍野区長池町22番22号  
㉑ 代 理 人 弁理士 福士愛彦

明 細 書

1 発明の名称

光増幅器

2 特許請求の範囲

1 複数の半導体レーザをレーザ光放射面上に  
配設し、各半導体レーザ間をレンズで光結合せ  
しめるとにより伝送された光信号を増幅する  
ことを特徴とする光増幅器。

2 前記半導体レーザは同一基板上に形成された  
~~半導体レーザは同一基板上に形成された半導体~~  
レーザアレイで構成された特許請求の範囲第1  
項記載の光増幅器。

3 発明の詳細な説明

本発明は半導体レーザを用いた光通信技術に於  
ける光増幅器に関するものである。

光ファイバの高性能化、低コスト化に伴い、  
光通信技術が実用化される段階にまで至っている  
が、長距離光通信の場合、その伝送距離はファイ  
バの材料特性から決定される吸収損失並びにフ  
アイバの屈曲等の形状、材料特性から決定

される屈折率損失によりその範囲が限定されてし  
まう。特に10 km以上の光情報伝送の場合は伝  
送速度が速く、かつファイバ内入力を大きくでき  
る半導体レーザの利用が有望となるが周波数100  
MHz以上で100 km以上の大都市間等の情報伝  
送の場合にはファイバによる吸収損失等を考慮す  
ると中継器が必要となる。特に衛星ケーブル等と  
して用いた場合には中継器は軽量、小型かつ高  
信頼性のものが必要である。

従来考えられている光中継器の構造としては、  
図1図に示す如くA点よりファイバ(1)を通して  
送られて来た光を一度アバランシエホトダイオ  
ード等の高感度光素子(2)で電気信号に変換すると  
もに該電気信号を増幅器(4)で増幅し、再び半導体  
レーザ(5)の入力信号とする方式が採用されてきた。  
しかしながらこの方式ではアバランシエホトダイ  
オードの高感度点や、高感度増幅器の必要性及び中  
継器の複雑化、各エレメントの増加による信頼性  
の低下、中継器自身の巨大化等により中継器とし  
ては好ましくない点が多い。

特開昭56-6492(2)

また、光増幅作用を有する半導体レーザの光カップリング効果（自己結合効果）を用いて半導体レーザ自身を光中継器として利用することが提案されているが、第2図に示す如くA地点より送られてきた光情報は、中継器のあるB地点では光量はファイバ内での吸収でまわめて小さくなり、光カップリング効果は起っていても $\frac{B}{A}$ 比はきわめて低く、地点に充分検知し得る信号を送ることが不可能である。

尚、図中実線は入力のない場合、破線は入力がある場合の特性図である。

本発明は以上の点に鑑み、各発振出力の異なる半導体レーザを光放射線上に結合させ、入力信号を各半導体レーザ間で逐次カップリングを起こさせることにより $\frac{B}{A}$ 比の高い出力信号を得ることのできる半導体レーザアレイの光増幅器を提供することを目的とするものである。

尚、以下の実施例では本発明の原理を明らかにする為、3つの半導体レーザアレイを用いた例を示すが高い出力信号を得る為にはレーザダイオー

ドを更に加えてもよく個数に關しては3つに限定するところではない。第3図は本発明の原理を説明するための説明図である。図に示す如く第1段目の半導体レーザ(11)（以下LDと略す）は第4図(a)に示す発振状態にありファイバ(12)より来る入力光信号によりカップリング効果によりわずかに発振状態が点(100)より出力増加の方向へ点(101)まで移行する。第2段目のLD(12)は第4図(b)に示す如く発振開始閾値電流(102)まで電流印加されているが第1段目のLD(11)の、カップリング効果による発振増加によりターンオンし点(103)で発振を開始する。第3段目のLD(13)は第4図(c)に示す如く点(104)で示すある発振状態に置かれているが第2段目のLD(12)の発振開始とともに点(105)の発振状態に移行して地点にカップリング時間の遅れのみで光信号を伝送することが可能である。

半導体レーザアレイは特性的に同一のものが望ましく、この点を考慮して本発明の他の特徴でもある同一基板上にかつエッチングプロセスにより

(3)

(4)

各個別化した半導体レーザアレイを使用する。第5図に示す如く各レーザの設定電流が外部抵抗(21)(22)で制御可能であることは同素子の使用上の簡便さを増す。

以上により高次のアレイは高さ方向にそろえることが極めて容易でカップリング効率を高め製造コストを低減することができる。

半導体レーザの材料としては本発明ではGaAs上にGaAlAs-GaAs-(GaAlAs)を蒸相成長させたダブルヘテロ構造の基板を使用した材料はInGaAsP等のダブルヘテロを形成する材料や、他のIII族半導体においても適用可能であり、特にアバランシェダイオードの作り難い材料に對しては極めて有望である。

次にレーザアレイのアラインメントについて説明する。第3図に示したレーザアレイを同一線上に並べると入力信号(34)が入力される以前に相互カップリングを起こしてしまい実質上光増幅は行なわれない。即ち、光の進行方向性に個性をもたせるために各素子間に光アイソレータが必要であ

るが、本実施例では各LDのアラインメントとレンズ組合に技術的手段を駆使することによって個性を付与した。第6図は半導体レーザアレイを平面方向よりみた図である。ファイバ(34)より伝送されてきた光信号(35)は集光レンズ(36)によりLD(31)に照射され、カップリングをなす。LD(31)の出力がファイバ(34)に入射されない様にファイバ(34)と集光レンズ(36)を配置する。LD(31)のストライプ(37)の出力端には第7図(a)に示すX-Z面にカーブを有するレンズ(38)が装着されており、LD(32)のストライプ(39)に入射される。LD(32)よりの入力端面(40)より出るレーザ光(41)はLD(31)に入射されることによる偏屈を防ぐ為、X-Z面に一面にAと凸部部分(42)を設けてある。また同様のレンズをLD(32)にも付設する。LD(31)の出力端面(40)より出た光は半円柱レンズのカーブ角度 $\theta$ (43)とレンズ材質の屈折率 $n$ で決定される角度を $\theta$ とすると

$$\theta = \sin^{-1} (n \sin \theta)$$

の方向に放射される。 $\theta$ が大きい程、逆方向のカ

(5)

(6)

(7)

#### 4 図面の簡単な説明

(9)

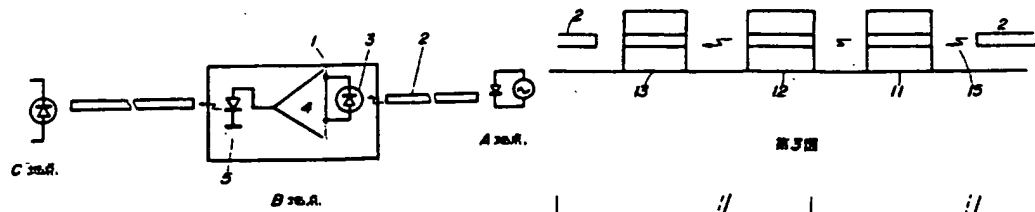
(a)

代理人 弁理士 福士 愛・郎

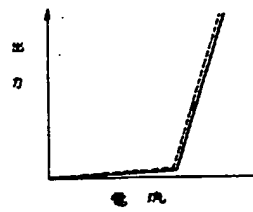
60

**BEST AVAILABLE COPY**

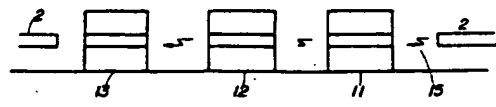
特開昭56-6492(4)



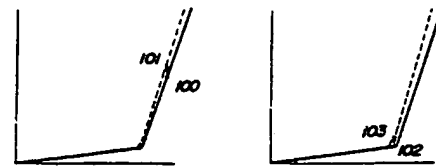
第1図



第2図



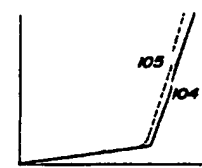
第3図



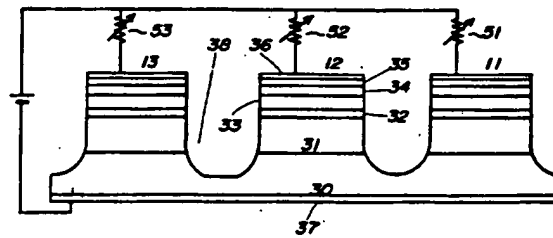
(A)

(B)

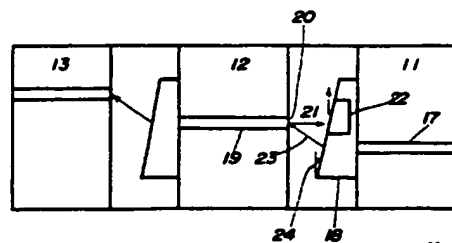
第4図



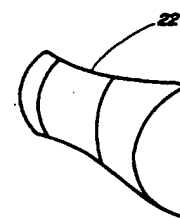
(C)



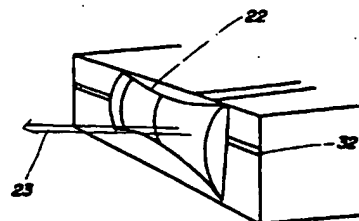
第5図



第6図



(A)



(B)

第7図